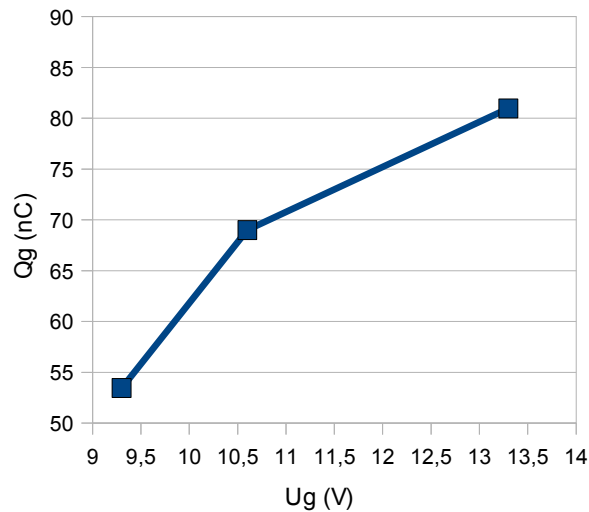


## ÚLOHA 2B – Jan Petrášek

Naměřená data a graf:

U <sub>g</sub> [V]	Q <sub>g</sub> [nC]
9,3	53,44
10,6	69
13,3	80,96



**Závěr:** Informaci ohledně kapacity MOSFET tranzistoru jsem také hledal v „oficiálních“ skriptech. Opět velmi stručně se zde hovoří o tenké vrstvě, která tuto kapacitu způsobuje, a jejím ochuzování (poklesu kapacity), ke kterému dochází při růstu napětí. Hodnot také není v tomto případě dostatečné množství, ovšem zlom v přímce přičítám právě očekávanému poklesu, **tedy výchozí předpoklad potvrzuji.**